

## MULTIPLE (QUAD) PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/558

### Devices

2N6987  
2N6987U

2N6988

### Qualified Level

JAN  
JANTX  
JANTXV  
JANS

### MAXIMUM RATINGS <sup>(1)</sup>

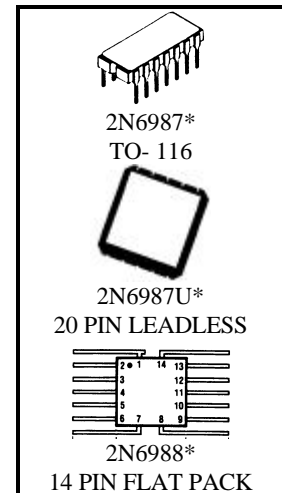
Ratings	Symbol	Value	Units
Collector-Emitter Voltage <sup>(4)</sup>	V <sub>CEO</sub>	60	Vdc
Collector-Base Voltage <sup>(4)</sup>	V <sub>CBO</sub>	60	Vdc
Emitter-Base Voltage <sup>(4)</sup>	V <sub>EBO</sub>	5.0	Vdc
Collector Current	I <sub>C</sub>	600	mAdc
Total Power Dissipation @ T <sub>A</sub> = +25 <sup>0</sup> C	P <sub>T</sub>	2N6987 <sup>(2)</sup>	1.5
		2N6987U <sup>(2)</sup>	1.0
		2N6988 <sup>(3)</sup>	0.4
Operating & Storage Junction Temperature Range	T <sub>op</sub> , T <sub>stg</sub>	-65 to +200	<sup>0</sup> C

1) Maximum voltage between transistors shall be ≥ 500 Vdc

2) Derate linearly 8.57 mW/<sup>0</sup>C above T<sub>A</sub> = +25<sup>0</sup>C

3) Derate linearly 2.286 mW/<sup>0</sup>C above T<sub>A</sub> = +25<sup>0</sup>C.

4) Ratings apply to each transistor in the array.



\*See appendix A for package outline

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25<sup>0</sup>C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

#### OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage I <sub>C</sub> = 10 mAdc	V <sub>(BR)CEO</sub>	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current V <sub>CB</sub> = 60 Vdc V <sub>CB</sub> = 50 Vdc	I <sub>CBO</sub>		10 10	μAdc ηAdc
Emitter-Base Cutoff Current V <sub>BE</sub> = 5.0 Vdc V <sub>EB</sub> = 3.5 Vdc	I <sub>EBO</sub>		10 50	μAdc ηAdc

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)**

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

**DC CHARACTERISTICS**

Forward-Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 0.1 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 1.0 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 10 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 150 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 500 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub>	h <sub>FE</sub>	75 100 100 100 50	450 300	
Collector-Emitter Saturation Voltage I <sub>C</sub> = 150 mA <sub>dc</sub> , I <sub>B</sub> = 15 mA <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 500 mA <sub>dc</sub> , I <sub>B</sub> = 50 mA <sub>dc</sub>	V <sub>CE(sat)</sub>		0.4 1.6	V <sub>dc</sub>
Base-Emitter Voltage I <sub>C</sub> = 150 mA <sub>dc</sub> , I <sub>B</sub> = 15 mA <sub>dc</sub> I <sub>C</sub> = 500 mA <sub>dc</sub> , I <sub>B</sub> = 50 mA <sub>dc</sub>	V <sub>BE(sat)</sub>		1.3 2.6	V <sub>dc</sub>

**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward-Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 50 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 20 V <sub>dc</sub> , f = 100 MHz	h <sub>fe</sub>	2.0	8.0	
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 1.0 mA <sub>dc</sub> , V <sub>CE</sub> = 10 V <sub>dc</sub> , f = 1.0 kHz	h <sub>fe</sub>	100		
Output Capacitance V <sub>CB</sub> = 10 V <sub>dc</sub> , I <sub>E</sub> = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C <sub>obo</sub>		8.0	pF
Input Capacitance V <sub>EB</sub> = 2.0 V <sub>dc</sub> , I <sub>C</sub> = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C <sub>ibo</sub>		30	pF



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331